

Solution !**高耐熱低熱膨張** **$T_g > 300^\circ\text{C} / \text{Low CTE}$**

高耐熱基板材料

RISHO High Heat Resistant Substrate Materials

**ガラス転移温度 300°C 以上
Eガラスでも $\text{CTE} = 6\text{ppm}/^\circ\text{C}$** **CS-3305A / ES-3310A**

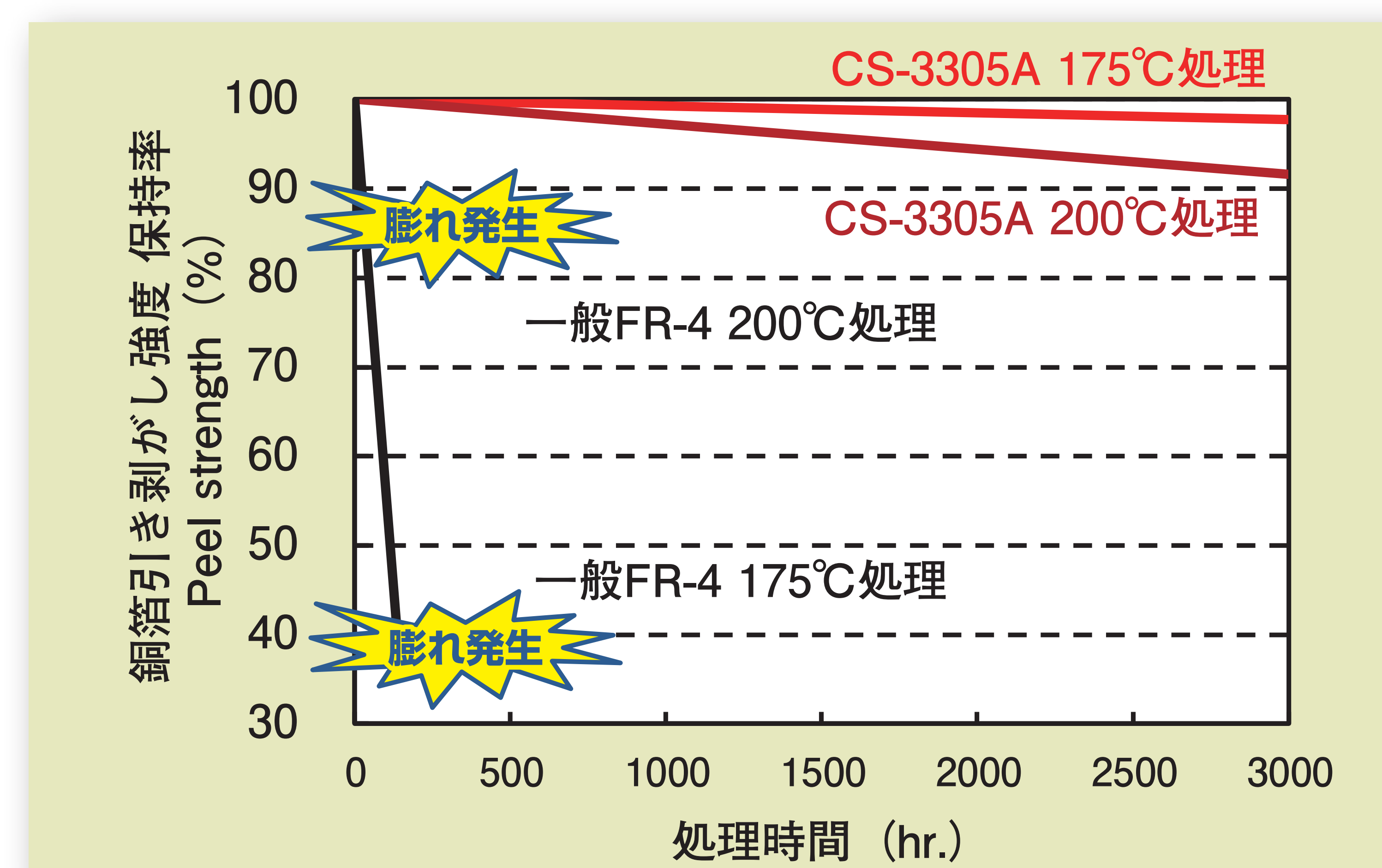
CCL

Prepreg

- ガラス転移温度(DMA法) = $300^\circ\text{C} <$
- 高温長期耐熱性に優れます。
- 低CTE(Eガラス仕様) = $6\text{ppm}(\text{XY})$
- Glass-transition temperature(DMA) = $300^\circ\text{C} <$
- Long term heat resistance
- Low CTE (E-Glass) = $6\text{ppm}(\text{XY})$
(S-Glass) = $3\text{ppm}(\text{XY})$
(Q-Glass) = $1\text{ppm}(\text{XY})$

高温処理の銅箔引き剥がし強度

Hot peel strength retention

**用途例**

Applications

車載用基板、半導体搭載用基板、パワーモジュール基板、超極薄基板 (板厚 $15\mu\text{m}$)

Substrate for Automotive, IC package, Power module

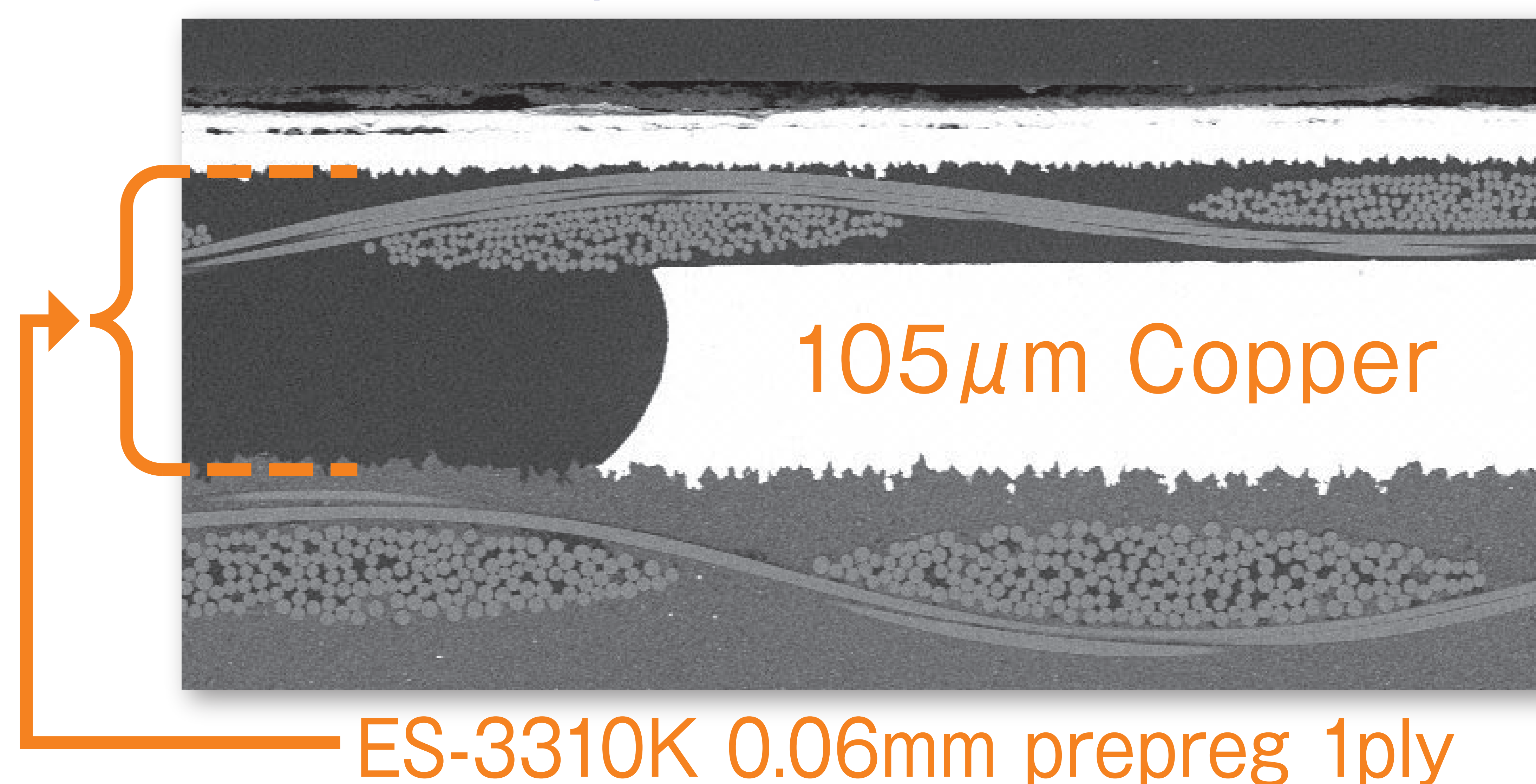
高耐熱 **$T_g > 300^\circ\text{C}$** **埋め込み性良好****CS-3305K / ES-3310K**

CCL

Prepreg

- ガラス転移温度(DMA法) = $300^\circ\text{C} <$
- ノンフィラー:加工性、埋め込み性良好
- Glass-transition temperature(DMA) = $300^\circ\text{C} <$
- Non filler:Excellent workability & embedability

▼厚銅の完全な埋め込み性

 $105\mu\text{m}$ Cu embedded substrate**用途例**

Applications

部品内蔵基板、バーンインボード基板、パワーモジュール基板

Device embedded substrate, Burn-in board, Power module